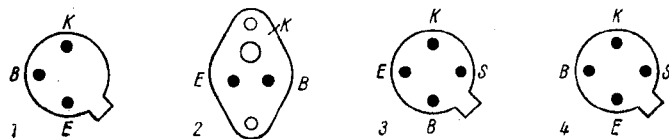


Neuere Transistoren der DDR-Fertigung

(siehe auch Tabelle in *Elektronisches Jahrbuch 1966*, S. 382)

Typ	$-U_{CB0}$ in V	$-I_{Cmax}$ in mA	P_{max} in mW	β	bei I_c in mA	f_T in MHz	R_{th} grad./mW	t_j in °C	Verwendung	An- schluß- schema
GC 102	15	50	—	> 29	2	6	0,5	75	} Vorstufentransistor rauscharmer Vorstufen- transistor	1
GC 103	15	15	—	> 29	2	> 1,2	0,5	75		1
GC 104	15	15	—	> 29	2	> 1,2	0,5	75		1
GD 125	66	1300	1000	> 15	500	0,200	15 grad./W	75	48-V-Schalttransistor	2
GD 175	50	3000	4000	> 15	1500	0,200	7,5 grad./W	75	48-V-Schalttransistor	2
GS 121	20	100	—	> 29	100	—	0,43	80	langsamer Schalttransistor	1
GF 108	15	15	—	> 29	2	6	0,5	75	} HF-Transistor für AM-ZF-Stufen Fe: in ein ZF-Verstärker	1
GF 126	25	10	50	> 40	1	> 1	0,6	75		3
GF 128	25	10	50	> 40	1	100	0,6	75		3

GF 129	25	10	50	>40	1	>10	0,6	75	für FM-ZF-Stufen	3
GF 145	20	10	60	—	—	>250	0,75	90	} Mesa HF-Transistor, Verstärkung bis 260 MHz	4
GF 146	20	10	60	—	—	>250	0,75	90		4
SF 121	20	100	600	>15	50	>60	0,25	175	} Planar-Transistor für HF-Verstärkung und Schaltzwecke	1
SF 122	33	100	600	>15	50	>60	0,25	175		1
SF 123	66	100	600	>15	50	>60	0,25	175	} Planar-Epitaxie-Transistor für HF-Verstärkung u. mit- telschnellen Schaltbetrieb	1
SF 126	33	500	600	>20	50	60	0,25	175		1
SF 127	66	500	600	>20	50	60	0,25	175		1
SF 128	100	500	600	>20	50	60	0,25	175		1
SF 131	20	50	300	>20	10	200	0,5	175	} Planar-Transistor	1
SF 132	40	50	300	>20	10	200	0,5	175		1
SF 136	20	200	300	>20	10	300	0,5	175	} Planar-Epitaxie-Transistor	1
SF 137	40	200	300	>20	10	300	0,5	175		1
GD 190	30						10		} neuer 4-W-Typ für GD 150 bis 180	
GD 191	40	1500	4000	20...80	—	0,350	°C/W	85		2
GD 192	50									
GD 240	30						4			
GD 241	40	3000	10000	20...80	2000	0,450	°C/W	85	} 10-W-Leistungstransistor	2
GD 242	50									